

a 2015 0067

Invenția se referă la procedeele de obținere a materialelor semiconductoare și poate fi utilizată în tehnologia semiconductoare.

Procedeul de obținere a monocristalelor de ZnO din faza gazoasă constă în creșterea acestora într-un volum închis cu utilizarea agenților chimici de transport. În calitate de agenți chimici de transport se utilizează HCl cu o presiune inițială la temperatura de creștere de 1...5 atm și hidrogen, care se menține în procesul de creștere la o presiune constantă egală cu 50...200% din presiunea inițială a HCl. Pentru creșterea monocristalelor se utilizează un germene de ZnO cu orientarea cristalografică [0001]Zn sau [000 $\bar{1}$]O. Creșterea se efectuează la temperatura de 980...1100°C.

Revendicări: 1

Figuri: 3